CEN-U05 CEN-U06 CEN-U07 NPN
CEN-U55 CEN-U56 CEN-U57 PNP

COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS

TO-202 CASE

Central Semiconductor Corp.

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:
The CENTRAL SEMICONDUCTOR CEN-U05/U55 series types are complementary silicon power transistors designed for general purpose audio amplifier applications. These devices are electrically equivalent to National Semiconductor's NSDU05, NSDU06, NSDU07, NSDU55, NSDU56, and NSDU57.

MARKING: FULL PART NUMBER

APPLICATIONS:
- Designed for general purpose high voltage amplifiers and drivers

FEATURES:
- High Collector-Emitter breakdown voltage
- High 10W power dissipation

MAXIMUM RATINGS: (T_C=25°C)	**SYMBOL**	**CEN-U05 CEN-U55**	**CEN-U06 CEN-U56**	**CEN-U07 CEN-U57**	**UNITS**
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	80	100	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	80	100	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}		4.0		V
Continuous Collector Current	I_C		2.0		A
Power Dissipation	P_D		10		W
Power Dissipation (T_A=25°C)	P_D		1.75		W
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}		-65 to +150		°C
Thermal Resistance	Θ_{JA}		71.4		°C/W
Thermal Resistance	Θ_{JC}		12.5		°C/W

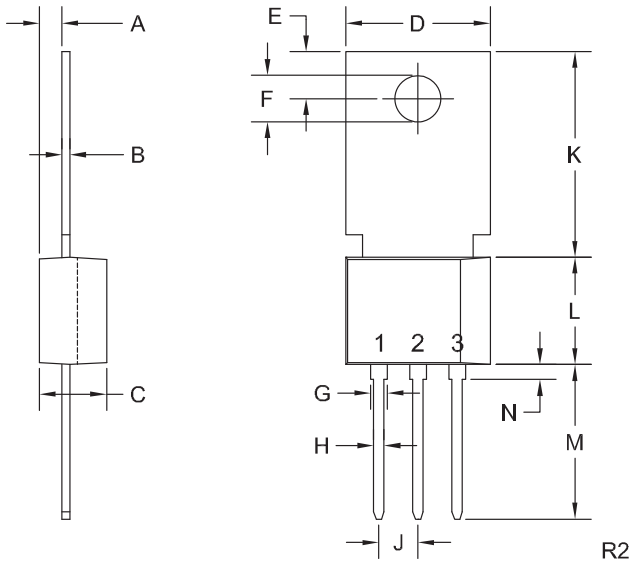
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (T_C=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**MAX**	**UNITS**
I_{CBO}	V_{CB}=Rated V_{CBO}		0.1	μA
I_{EBO}	V_{EB}=4.0V		100	μA
BV_{CEO}	I_C=1.0mA (CEN-U05, CEN-U55)	60		V
BV_{CEO}	I_C=1.0mA (CEN-U06, CEN-U56)	80		V
BV_{CEO}	I_C=1.0mA (CEN-U07, CEN-U57)	100		V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=250mA, I_B=10mA		0.5	V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=250mA, I_B=25mA		0.35	V
$V_{BE(ON)}$	V_{CE}=1.0V, I_C=250mA		1.2	V
h_{FE}	V_{CE}=1.0V, I_C=50mA	80		
h_{FE}	V_{CE}=1.0V, I_C=250mA	50		
h_{FE}	V_{CE}=1.0V, I_C=500mA	20		
f_T	V_{CE}=5.0V, I_C=200mA, f=100MHz	50		MHz
C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0MHz		30	pF

CEN-U05 CEN-U06 CEN-U07 NPN
CEN-U55 CEN-U56 CEN-U57 PNP

COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS

TO-202 CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:
1) Emitter
2) Base
3) Collector
Tab is common to pin 3

MARKING:
FULL PART NUMBER

DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.055	0.071	1.40	1.80
B	0.016	0.024	0.40	0.60
C	0.173	0.181	4.40	4.60
D	0.374	0.413	9.50	10.5
E	0.118	0.154	3.00	3.90
F (DIA)	0.124	0.150	3.15	3.80
G	0.035	0.055	0.90	1.40
H	0.023	0.031	0.59	0.80
J	0.094	0.106	2.39	2.69
K	0.459	0.559	11.66	14.21
L	0.280	0.346	7.12	8.80
M	0.406	0.531	10.3	13.5
N	0.024	0.059	0.60	1.50

TO-202 (REV: R2)

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9